ECMP

Electro-Chemical Mechanical Polishing

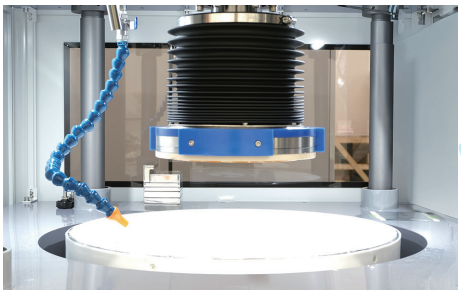
Workpiece material
Diamond

電気化学機械研磨技術

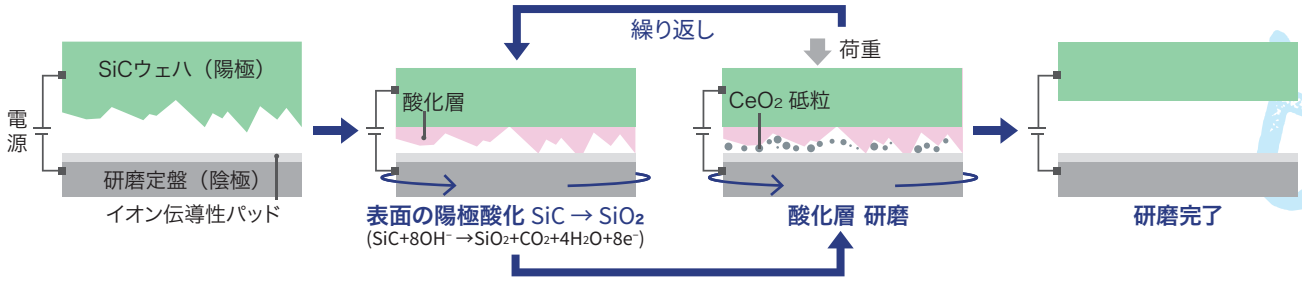
ECMP装置 / EP100



内部イメージ

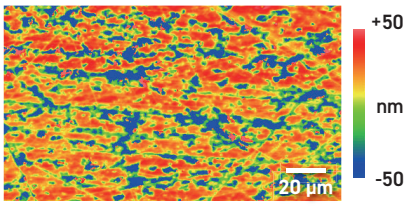


加工原理とフロー



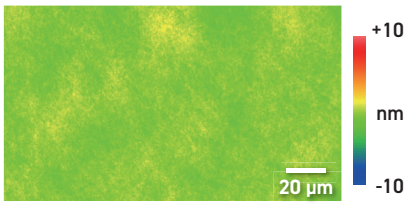
加工事例 4H-N SiC サイズ：4 inch 加工面：Si 面

加工前



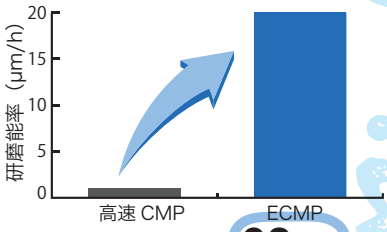
Before ECMP Sa: 26.4 nm

加工後



After ECMP Sa: **0.25** nm

ECMPと高速CMPの研磨能率



Polishing Rate: **20** μm/h

- 固体電解質によるワーク表面の陽極酸化（軟質化）現象を利用
- イオン伝導性パッドを用いることで、薬液不要

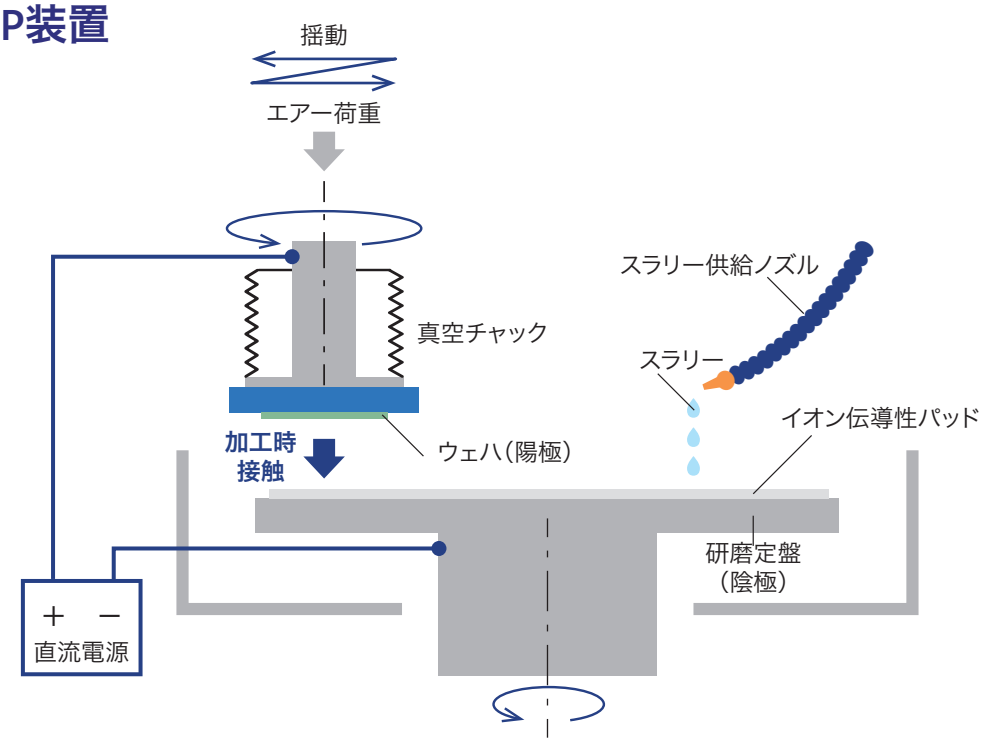
→ 「クリーン」で「高効率」な研磨を実現

CMPに代わるSiCの高効率な研磨に最適

データ提供：立命館大学

ジェイテックコーポレーション

ECMP装置



一般仕様

モデル		EP100
基本仕様	ウェハサイズ	6〜8 インチ※
	対象ウェハ種	SiC
	プラテン数	1
	研磨ヘッド	1
	装置寸法	W1,200 mm　× D1,430 mm　× H2,400 mm
	装置重量	約1,800 kg
研磨ユニット仕様	印加荷重範囲	10〜150 kgf
	研磨ヘッド回転数	10〜90 rpm
	定盤回転数	10〜150 rpm
	揺動ストローク	±55 mm(6インチ)／ ±30 mm(8インチ)
ユーティリティ	電　　源	3 相 AC 200 V･60 A
	計装エアー	0.4〜0.6 MPa (CDA)
	廃　　液	装置後部より排液ホースにて外部へ自然排出

※その他のウェハサイズについてはお問い合わせください

株式会社ジェイテックコーポレーション
〒567-0086 大阪府茨木市彩都やまぶき2-5-38
https://www.j-tec.co.jp/

お問い合わせは(営業直通)
072-655-2786
受付時間：土、日、祝日及び当社指定定休日を除く、9時〜17時30分

JTEC CORPORATION

■記載されている会社名、製品名および商品名は株式会社ジェイテックコーポレーションの商標または登録商標です。■記載の測定例は代表例であり、性能を保証するものではありません。■製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷の性質上、実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2026年11月作成